

2024年1月31日(水)

開始時間	終了時間	duration	内容	ID	タイトル	所属	講演者
20:00	21:30	1:30	チュートリアル		半導体製造における分析・計測技術の最前線	日立製作所	人見 敬一郎

2024年2月1日(木)

開始時間	終了時間	duration	内容	ID	タイトル	所属	講演者
9:00	9:10	0:10	Opening				
1 酸化物半導体・メモリデバイス・Si-MOS界面							
9:10	9:40	0:30	招待講演		原子層堆積法によるナノシート酸化物半導体トランジスタ	東京大学	小林 正治
9:40	10:00	0:20	一般講演	30	原子層堆積法で成膜した非晶質/多結晶In-Ga-Oトランジスタの信頼性	奈良先端大	高橋 崇典
10:00	10:20	0:20	一般講演	12	極薄膜AlN酸化で生成したワイドバンドギャップAl ₂ O ₃ 膜によるリーク電流低減実現	キオクシア	中島 裕亮
10:20	11:10	0:50	Break				
2 基調講演・ロジックプロセス							
11:10	12:00	0:50	基調講演		Advanced Logic Transistor Process Technology Towards 1-nm Node	Applied Materials	吉田 尚美
12:00	12:10	0:10	写真撮影				
12:10	13:30	1:20	Lunch				
3 ポスターセッション							
13:30	15:00	1:30	ポスターセッション				
15:00	15:30	0:30	Break				
4 企画セッション							
15:30	16:50	1:20	企画セッション		2nmノード & Beyondテクノロジーを見据えたロジックデバイスの開発動向		
16:50	17:00	0:10	Break (移動)				
17:00	17:30	0:30	オーサーズインタビュー				
懇親会 (立食)							
17:30	19:30	2:00	懇親会				

2024年2月2日(金)

開始時間	終了時間	duration	内容	ID	タイトル	所属	講演者
8:45	8:50	0:05	2日目案内				
5 基調講演II・Si量子ビット							
8:50	9:40	0:50	基調講演		シリコン量子ビットデバイスの特性における界面の影響	理化学研究所	小林 嵩
9:40	10:10	0:30	招待講演		シリコン量子ビット技術と集積化に向けた研究開発	東京工業大学	小寺 哲夫
10:10	10:40	0:30	Break				
6 リザーブコンピューティング・2次元材料							
10:40	11:10	0:30	招待講演		金属酸化物およびLi イオンを用いた不揮発素子と脳型リザーブコンピューティング等への応用	東芝	丸亀 孝生
11:10	11:40	0:30	招待講演		二次元異種材料の接合技術と新機能創出	東京大学	町田 友樹
11:40	12:00	0:20	一般講演	21	単原子長ゲート構造への二次元半導体結晶の成長	東北大	杉野 秀明
12:00	13:00	1:00	Lunch				
7 Ge・GeSn・高周波デバイス							
13:00	13:20	0:20	一般講演	34	In ₂ O ₃ 系透明導電性酸化膜電極を用いたGeショットキーフォトダイオードの感度特性評価	東理大	石井 寛仁
13:20	13:40	0:20	一般講演	26	Si基板上 GeSn 細線のレーザー-溶融結晶化におけるレーザー-走査条件と下地 SiO ₂ 膜厚の最適化	阪大	早川 雄大
13:40	14:00	0:20	一般講演	32	GeSn/GeSiSn二重障壁構造における負性微分抵抗の発現	名大	石本 修斗
14:00	14:20	0:20	一般講演	17	InN MOVPE成長過程におけるTMIn分解・反応経路に関する理論研究	名大	長嶋 佑哉
14:20	14:45	0:25	Break				
8 パワーデバイス・SiC・GaN							
14:45	15:15	0:30	招待講演		パワー半導体に向けたダイヤモンドMOSFETの最近の進展	佐賀大学	嘉数 誠
15:15	15:35	0:20	一般講演	14	GaN/SiO ₂ 界面におけるGaOx界面層中のMg _{Ga} とVoの相互作用	名大	服部 柊人
15:35	15:55	0:20	一般講演	15	CVD 環境下におけるSiC(0001)表面へのN原子取り込み機構の理論研究	名大	山内 颯一郎
15:55	16:15	0:20	一般講演	31	4H-SiCにおける基底面転位(BPD)の第一原理計算を用いた電子構造解析 ~バイポーラ劣化現象の物理的起源の解明~	名大	佐野 雅季
16:15	16:35	0:20	一般講演	33	SiO ₂ ダミープロセスを用いたc及びm面のGaN/Al ₂ O ₃ /PtキャパシタのPBS特性の改善	NIMS	生田目 俊秀
16:35	16:45	0:10	Break				
表彰式・閉会式							
16:45	17:05	0:20	Closing		表彰式など		

ポスターセッション：2月1日(木) 13:30-15:00

Poster	ID	タイトル	所属	講演者
1	20	C軸配向AlScNを用いた固相成長ポリシリコンチャンネルの結晶制御	東京都市大	野秋 元
2	24	HfZr酸化物へのNi電極形成が結晶構造および化学結合状態に与える影響	名大	佐野 友之輔
3	46	強誘電体Hf _{1-x} Zr _x O ₂ /TiNの界面反応に起因する分極疲労抑制メカニズムに関する考察	東大	女屋 崇
4	43	XPSスペクトルのNoise2Noiseデノイズングによる多層積層薄膜界面の高精度時空間深さ方向可視化	シエントアオミクロン	豊田 智史
5	16	角度分解2光子光電子分光法を用いたホールサブバンドの高分解能測定	東レリサーチ	坂田 智裕
6	40	SiN膜に含まれる水素の化学結合状態と分布に与える水素プラズマ処理の影響のAR-HAXPES評価	東京都市大	桐原 芳治
7	19	水素プラズマ処理によるALD-SiO ₂ 膜中トラップエネルギー準位の深化	東京都市大	藤田 雄輝
8	35	電子線照射によるSiO ₂ /Si界面欠陥生成	筑波大	清水 峻央
9	22	MOS構造における界面準位密度分布とコンダクタンスカーブ形状の関係	愛工大	田岡 紀之

10	44	一次元連結・高密度Si量子ドットの形成と局所帯電特性評価	名大	今井 友貴
11	45	極薄熱酸化SiO ₂ 上の自己組織化Si量子ドットの形成機構	名大	白 鍾銀
12	39	In-situ SbドーピングによるInP上n型Ge _{0.75} Sn _{0.25} エピタキシャル膜の形成	名大	柴山 茂久
13	38	Al/GeSn(111)構造上への熱処理による極薄・高Sn組成GeSn表面偏析	名大	柴山 茂久
14	25	Al/SiGe(111)/Si(111)構造の化学構造分析 - 熱処理による Si および Ge 偏析 -	名大	酒井 大希
15	23	表面酸化処理したSi/Ni/Si構造の熱処理によるSiO ₂ 上への極薄NiSi ₂ 膜形成	名大	木村 圭佑
16	18	Ar イオン注入した多層 MoTe ₂ の熱処理によるテルルナノシート形成	東京都市大	村中 柊都
17	29	2層MoS ₂ /h-BN MISキャパシタでの界面準位密度の測定	千葉大	鶴岡 大樹
18	36	ALDの実現に向けたオゾン処理と真空アニールによる WSe ₂ 表面へのSe欠陥導入	千葉大	小島 拓也
19	27	4H-SiC/SiO ₂ 界面におけるバンド配列の理論解析: 界面双極子形成の検討	三重大	松田 隼
20	13	GaN-MOS界面の酸化ガリウム層における原子配列評価	産総研	上沼 陸典
21	42	界面エネルギー計算にもとづくα-Al ₂ O ₃ (0001)基板上Ga ₂ O ₃ の構造安定性の理論的検討	三重大	戸田 康太
22	41	化学溶液洗浄したβ-Ga ₂ O ₃ 表面の光電子分光分析	福岡大	大田 晃生